

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 研磨対象物を精度よく研磨できる研磨装置及び研磨方法を提供する。

【解決手段】 研磨装置は、半導体ウエハWの被研磨面と研磨パッド101とを相対的に摺動させて被研磨面を研磨する。研磨装置は、半導体ウエハWの被研磨面の裏面を押圧することで、被研磨面を研磨パッド101に押圧するエッジ室8と、半導体ウエハWの研磨中に、半導体ウエハWの被研磨面の残膜プロファイルをリアルタイムに推定する膜厚測定部40と、半導体ウエハWの研磨中に、膜厚測定部40の測定結果に応じて、エッジ室8による被研磨面の裏面に対する押圧を制御する閉ループ制御装置502とを備える。閉ループ制御装置502は、半導体ウエハWの研磨中のエッジ室8による押圧の制御とともに、被研磨面の研磨パッド101に対する押圧に影響を与えるエッジ室8の周辺部としてのリテーナリング3の圧力を制御する。

【選択図】 図4